








	<p>IPB80N06S2L07ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB80N06S2L07ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> <p>Datenblätter:  IPB80N06S2L07ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N06S2L07ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	210W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3160pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N06S2L07ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S2L07ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S2L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB80N06S2L07ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB80N06S2L06ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S2L06ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S2L11ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S2L11ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>
 <p>IPB80N06S2L09ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S2L09ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S2L-H5 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S2L-11 INF IPB80N06S2L-11 INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB80N06S2L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80N06S2L07ATMA1 Datenblatt	IPB80N06S2L07ATMA1-Datenblätter	IPB80N06S2L07ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S2L07ATMA1
IPB80N06S2L07ATMA1 Electronic	IPB80N06S2L07ATMA1-Komponenten	IPB80N06S2L07ATMA1-Verteiler	IPB80N06S2L07ATMA1-Bild	IPB80N06S2L07ATMA1-Teil
IPB80N06S2L07ATMA1 Preis	IPB80N06S2L07ATMA1 Hersteller	IPB80N06S2L07ATMA1 Bild	IPB80N06S2L07ATMA1 Aktie	IPB80N06S2L07ATMA1 Inventar
IPB80N06S2L07ATMA1 Neu	IPB80N06S2L07ATMA1 Original	IPB80N06S2L07ATMA1 garantiert	IPB80N06S2L07ATMA1 RFQ	IPB80N06S2L07ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited